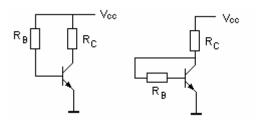
TD N°3: Les Transistors bipolaires

(Polarisation et régime de commutation)

Exercice 1

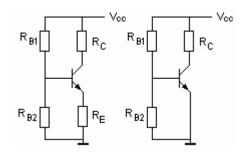
Calculer les résistances nécessaires à la polarisation d'un transistor NPN au silicium dans chacun des deux montages suivants. On donne β = 100 , $\,$ Vcc = 10V et on désire que le point de repos soit fixé à V_{CE0} = 5V , $\,$ I $_{C0}$ = 1mA et $\,$ V $_{BE0}$ = 0.7V .



Exercice 2

un transistor NPN au silicium est polarisé par pont de base selon les schémas ci-dessous. On donne β = 100 , V_{CE0} = 5V I_{C0} = 1mA et V_{BE0} = 0.7V .

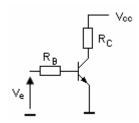
- calculer les éléments de polarisation.
- Déterminer les droites d'attaque et de charge.



Exercice 3

Le transistor dans le montage ci-contre travaille en régime de commutation.

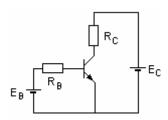
- Déterminer le courant de saturation I_{Csat}.
- Quelle est la valeur de I_{Bs} nécessaire pour produire la saturation.
- Quelle est la valeur minimale de Ve nécessaire pour produire la saturation. On donne β = 150 , Vcc = 5V , R_B = 1M Ω , R_C = 10k Ω V_{BE0} = 0.7V .



Exercice 4

Un transistor NPN au silicium est utilisé dans le montage ci-contre. On donne β = 120 , $~E_C$ = 12V , V_{BE} = 0.7V , R_B = $50k\Omega$, R_C = 1k Ω . La FEM E_B croit lentement de -5V à +15V.

- Déterminer à partir de quelles valeurs de E_B le transistor cesse d'être bloqué, puis le transistor commence à être saturé.
- Construire les graphes $I_C = f(E_B)$ et $V_{CE} = f(E_B)$

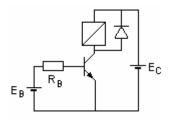


Exercice 5

Le transistor du montage ci-dessus fonctionne en commutation. Dans son circuit de collecteur est placée la bobine d'un relais NO. $E_B=5V$, $E_C=24V$

 $\begin{aligned} & Transistor: \ \beta = 100 \ , V_{CEsat} = 0.1V \\ & Bobine: \ V_N = 24V \ \ , \ R_{bo} = 100\Omega \end{aligned}$

- Calculer le courant circulant dans la bobine du relais.
- Déterminer le courant I_B nécessaire pour saturer le transistor.
- En déduire la valeur de la résistance de base R_B.



Exercice 6

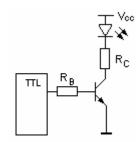
Le montage ci-contre sert à visualiser la sortie d'un opérateur logique a l'état haut par l'intermédiaire d'une LED :

LED:
$$V_D = 1.6V$$
, $I_D = 20mA$.

Transistor :
$$\beta_{min}$$
 = 100 , V_{BE} = 0.7V , V_{CEsat} = 0.2V

Opérateur logique TTL : $V_{OHmin} = 2.4V$, $I_{OHmax} = 0.4mA$

- quel est le rôle du transistor ?
- Dimensionner les éléments résistifs si Vcc = 5V

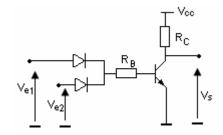


<u>2011-2012</u> 1

Exercice 7

Le transistor dans le montage ci-contre travaille en régime de commutation. Complétez le tableau et déduire la fonction du montage.

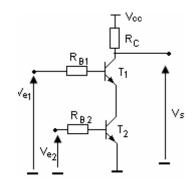
V _{e1}	V_{e2}	D ₁	D_2	T	V _s



Exercice 8

Le transistor dans le montage ci-contre travaille en régime de commutation. Complétez le tableau et déduire la fonction du montage.

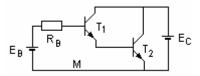
V _{e1}	V_{e2}	T1	T2	V_s



Exercice 9

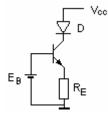
On considère le montage ci-contre (dit montage Darlington) $\beta_1=100$, $\beta_2=50$, ~Vcc=12V , $~R_B=100k\Omega$, $V_{BE}=0.7V$.

- Etablir une relation entre I_{B1} et I_{C2} .
- Calculer la tension $V_{\mbox{\scriptsize B1M}}$. Que peut-on conclure ?
- $SiI_{C2} = 50mA$, calculer la tension E_B et la puissance consommée par chaque transistor.



Exercice 10

- Calculer le courant qui circule dans la diode. On donne : Vcc=5V , $R_B=100\Omega$, $E_B=2V$.
- Les caractéristiques du transistor utilisé ont-elles une influence sur le fonctionnement du montage ?



<u>2011-2012</u> 2

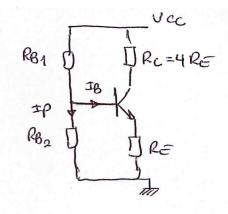
Therefore
$$V_{CES} = \frac{V_{CC}}{2} = 50$$
 TDN3

 $V_{RES} = 0.4V$.

 $V_{CE} + R_{C}, R_{C} = V_{CC} \Rightarrow R_{C}$

$$+ V(E + Rc (1c + IB) = Vec$$

$$\Rightarrow Re = \frac{Vec - VeE}{Ic + IB} = \frac{Vec - VeE}{Ic (1 + \frac{1}{B})}$$

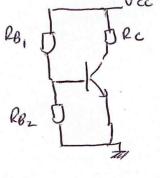


au Paul de reposi
$$RE = \frac{Vcc - VcEo}{5Ico}$$

$$= \frac{Vcc}{5.2.1} = \frac{5 \text{ kg}}{5}$$

$$= \frac{102 - 100}{10 - 100} = \frac{100 - 100}{100 - 100} = \frac{100 - 100}{100 - 100}$$

$$=\beta\left(\frac{R_{E}I_{CO}+VBE_{0}}{L_{0}I_{CO}}\right)=14kn.$$



$$R_{ETE} + U_{CE} + R_{C}I_{C} = U_{CC} = 0$$

$$(I_{E} \approx I_{C})$$

$$= \frac{10 - U_{CE}}{5RE} = \frac{10 - U_{CE}}{5}$$

Exercise
$$Y$$
 $\# E_B = \frac{E_B - V_B E}{RB} \eta' existe fue 6i E_B > V_B E = 0, 7 V$

(Il Courent IB doit être Posshif)

=> Transistor usse d'ahe beoguée ds pu EB = 0,7V.

* le transistor Commente à che soturé lorsque

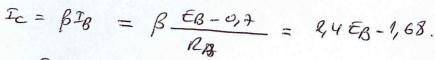
$$I_B = I_{BS} = \frac{I_{CSO}f}{\beta}$$
.

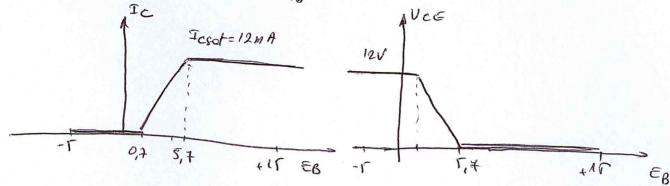
Foset =
$$\frac{\epsilon_c}{Rc}$$
 (d'epres le donte de charge si $V_{CE} = 0$)
$$= \frac{12}{1} = 12 \text{ m A}$$

=)
$$I_{BS} = \frac{E_B - V_{BE}}{R_B} = E_B = R_B I_{BS} + V_{BE} = 50.0,1 + 9.7$$

= 5,7 V

$$\delta \in \mathcal{B} \leq 0,7 \implies \mathcal{I}_{\mathcal{B}} = 0 \implies \mathcal{I}_{\mathcal{C}} = 0$$
, $V_{\mathcal{CE}} = \mathcal{E}_{\mathcal{C}} = 12V$
 $\delta \in \mathcal{B} \gg 1,7V \implies \mathcal{I}_{\mathcal{B}} \gg \mathcal{I}_{\mathcal{BS}}$, $\mathcal{I}_{\mathcal{CE}} = \mathcal{I}_{\mathcal{CSOP}} = 12WA$, $V_{\mathcal{CE}} = 0$
 $0,7 \iff 1,7V \implies 1$ $0,7V \implies 1$





EXERCICE 5

*
$$I_c = \frac{E_c - V_{cESot}}{R_{bo}} = \frac{23.9}{100} = 239 \, \text{mA}$$

*
$$IBS = \frac{Icsot}{\beta} = \frac{239}{100} = 2,39 \text{ mA}$$

*
$$R_B = \frac{E_B - V_B E}{E_B} = \frac{5 - 0.7}{2.39} = 1.79 \, \text{ku} \, \approx 1.7 \, \text{ku}$$

EXELCICE 6

* paisque d'operateur logique ne peut delivrer peus de 0,4 m A
pour l'etat haut minimel, dont il n'est pas capable
d'ellumer de LED d'où le tronsstor & necessair.

$$Rc = \frac{v_{cc} - v_{cesot} - v_{o}}{F_{o}} = \frac{5 - o_{i}2 - t_{i}6}{20 \text{ mA}} = 160 \text{ n}$$

E204

Ero 8

Exo9

$$I_{b2} = I_{c_1} + I_{b_1} = (\beta_1 + 1) I_{b_1}$$

 $I_{c_2} = \beta_2 I_{b_2} = \beta_2 (\beta_1 + 1) I_{b_1} = 5050 I_{b_1}$

*
$$IC_2 = Som4 \implies IB_1 = \frac{IC_2}{Foro} = 9,90 \text{ MA}$$

$$=) E_B = P_B I_{B1} + 1.4 = 2,40.$$